

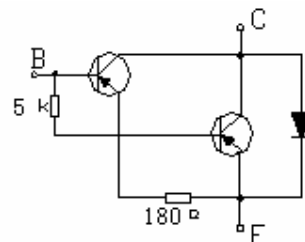
## TIP127

### 硅 PNP 外延平面达林顿晶体管芯片

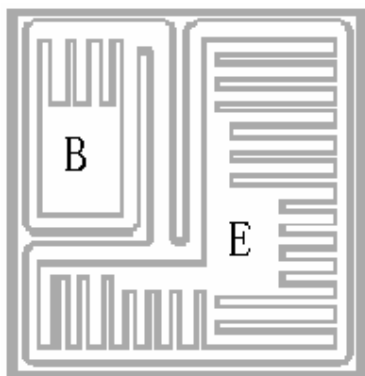
■ 用途:

- \* 电源调整管
- \* 音频功率放大器
- \* 其他电子电路

■ 内部结构:



■ 芯片示意图:



■ 几何结构:

芯片尺寸	2140 μ m × 2140 μ m
压焊区尺寸	基 极 440 μ m × 600 μ m 发射极 450 μ m × 600 μ m
锯片槽宽度	90 μ m
芯片厚度	270 ± 10 μ m
金属层	正面 Al 3.5 ± 0.4 μ m 背面 Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■ 电特性 (T<sub>a</sub>=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =-0.1mA, I <sub>E</sub> =0	-180	-100		V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =0	-160	-100		V
集电极-发射极维持电压	V <sub>CEO (sus)</sub> *	I <sub>C</sub> =-30mA, I <sub>B</sub> =0		-100		V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>B</sub> =-2.5mA, I <sub>C</sub> =0		-10		V
集电极-基极截止电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =-100V, I <sub>E</sub> =0			-1	μ A
集电极-发射极截止电流	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> =-100V, I <sub>B</sub> =0			-1	μ A
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =-10V, I <sub>C</sub> =0	-2.0		-2.5	mA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =-2A	4000	2000	15000	
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CES</sub>	I <sub>C</sub> =-3A, I <sub>B</sub> =-12mA	-1.3		-2	V

\* V<sub>CEO (sus)</sub>: 脉宽≤300 μ s, 占空比≤2% (TO-220)